Serial No.: 10/535,311 Docket No.: 28955.1050

<u>REMARKS</u>

Claims 3, 5-8, 10-13 and 26-34 and 37, as amended, remain herein. Claims 26-34 have been cancelled.

Claims 3, 5-8, 10-13, 26-34 and 37 were rejected under 35 U.S.C. § 103(a) over Sakai et al. U.S. Patent Application Publication 2002/0136922 with evidence from Hosokawa et al. U.S. Patent 7,087,322. The Office Action alleges that Sakai discloses a light-emitting layer material (bisanthracene compound 6-1), a first dopant (DPVDPAN), and a second dopant (DMPAVB). In addition, the Office Action alleges that Sakai suggests the use of lower amounts of DPVDPAN.

Applicants' claims 26 and 35 recite an organic electroluminescence element comprising: a pair of electrodes, and a light emitting layer provided between the pair of electrodes, the layer comprising a light-emitting-layer material, a first dopant and a second dopant that satisfy the following relations: EVO > EV1 and EVO > EV2; $ECO \ge EC1$ and ECO > EC2; $EGO > EG1 \ge 2.6$ eV and $EGO > EG2 \ge 2.8$ eV, wherein each of the first dopant and the second dopant comprises 20 wt% or less of the light emitting layer.

Contrary to the assertion in the Office Action, Sakai nowhere suggests the use of DPVDPAN in 20 wt% or less. Paragraphs [0015] and [0033] of Sakai, which are cited as allegedly supporting a lower content of DPVDPAN, are reproduced below:

[0015] The compound represented by general formula (1) may be used singly or in combination of two or more.

. . .

[0033] In the organic EL device of the present invention, it is preferable that the ratio of the amount by weight of the light emitting material to the amount by weight of the biscondensed aromatic cyclic compound in the layer of organic compounds is in the range of

Serial No.: 10/535,311 Docket No.: 28955,1050

100:1 to 40:60 since the crystallization of the layer of organic compounds can be efficiently suppressed in driving the device for a long time or under change in the thermal environment without influence on the electric properties or the life of the device.

Paragraph [0015] of Sakai suggests the use of DPVDPAN in combination with another material but nowhere suggests the use of DPVDPAN in 20 wt% or less. Paragraph [0033] of Sakai suggests that the content of DPVDPAN ranges from 40 to 100%. The Office Action speculates that if two light emitting compounds are used, each would be in a content of 20%. However, this reasoning assumes that the total level of light emitting material would be 40%. It is clear that DPVDPAN is used as a host material not as a dopant in Sakai. The bis-condensed aromatic cyclic compound is used in a content of 1 to 60% for the purpose of suppressing crystallization in the light emitting layer (see Sakai at Paragraph [0016]). All the examples in Sakai disclose the use of light emitting material of formula (1) (e.g., DPVDPAN) at a content of 49% or more. Sakai nowhere suggests the use of DPVDPAN as a dopant. A dopant performs a different function from a host material.

When the content of the dopant is too high, the molecules of the dopant contact each other, thereby causing concentration quenching. See, e.g., U.S. Patent Application Publication 2002/030441 at ¶ [0017]; U.S. Patent 6,447,934 at column 7, lines 64-67. See also, pages 52-53 of the enclosed Organic Electroluminescence Technology and Material Development article (see page including English translations). The article shows that luminescent efficiency is significantly reduced at dopant concentration of 20 wt% or more.

Differences in concentration are not obvious when there is evidence indicating such concentration is important to proper functioning of the invention. See MPEP § 2144.05(II)(A). In this case, applicants' specification explains that:

Serial No.: 10/535,311 Docket No.: 28955,1050

In this technique, however, the light emitting layer captures both kinds of charges of holes and electrons by using a <u>single luminescent dopant</u>; therefore, the <u>luminescent wavelength therefrom is inconveniently long</u>. In other words, when materials are selected respectively in order to make the injection efficiency of charges from electrodes good, the energy gap between the valence electron level of the selected hole transporting material and the conductive level of the selected electron transporting material becomes about 2.5 eV or less, so as to cause a problem that light having a longer wavelength than yellowish green wavelengths is emitted.

In order to make the durability of an organic EL element longer, a luminescent dopant having an electron trapping property is added thereto. When the addition concentration thereof is increased to sufficiently obtain the advantageous effect of the dopant, the electron trapping property becomes stronger so as to cause a problem that the driving voltage of the organic EL element becomes high.

Further, when the addition concentration becomes larger, the molecules of the dopant contact each other, thereby causing concentration quenching to result in a problem that the efficiency of the organic EL element becomes low.

. . .

A dopant needs to be added up to a concentration that the dopant can sufficiently capture holes injected into the light-emitting-layer material. In the case that two kinds of dopants having the above-mentioned relations are added, the concentration of the each of the dopants is relatively smaller than in the case that only one kind of dopant is added. It is therefore possible to restrain concentration quenching based on contact between the dopants. For this reason, the durability of the organic EL element can be made long.

. . .

The amounts of the first and second dopants added to the whole of the light emitting layer are each preferably 20% or less by weight, in particular preferably from 1 to 10% by weight. If each of the amounts is more than 20% by weight, the concentration of the dopant is too high so that the luminescent efficiency may lower.

Applicants' specification, page 4, lines 4-28; page 13, line 29 to page 14, line 8; and page 26, lines 21-26 (emphasis added here). Thus, a person of ordinary skill in this art would not view Sakai's use of DPVDPAN as a dopant, but as a host, because of its content and because of the phenomenon of concentration quenching. Furthermore, Sakai's Example 1 demonstrates the significance of dopant concentration. The device of Sakai's Example 1 has a driving voltage of

Serial No.: 10/535,311 Docket No.: 28955.1050

7V while applicants' Example 1 which also includes DPVDPAN has a much lower driving voltage of 5 V, which demonstrates the superiority of applicants' claimed invention over Sakai.

In addition, Sakai nowhere discloses the use of two dopants. Applicants' use of specific amounts of two dopants which have specific valence electron levels, specific conduction levels, and specific energy gaps relative to the light emitting material, is not obvious and achieves an organic electroluminescence element having unexpectedly superior luminance, efficiency, and durability (compare applicants' Examples 1-5 to Comparative Examples 2, 4, 6 and 9 in Table 3, at pages 49-50 of applicants' specification).

Furthermore, Sakai does not disclose applicants' claimed relationship $EC0 \ge EC1$. The Office Action alleges that a difference of 0.07 eV between EC0 and EC1 is obvious and that a person of ordinary skill in the art would expect that the device would function in a similar manner to a device in which EC0 = EC1. However, as explained in applicants' specification, the conduction level of the dopant is lower than that of the light-emitting-layer material.

As shown in FIG. 2, in this light emitting layer, the conduction level EC0 of the light-emitting-layer material is not less than the conduction level EC1 of the first dopant and the conduction level EC2 of the second dopant. That is, the relation of EC0 \geq EC1, EC2 is satisfied. The purpose of this is to cause each of the dopants not to capture electrons. The element having such a structure can be driven at a low voltage.

Applicants' specification, page 13, lines 13-20 (emphasis added here). Because the conduction level of DPVDPAN is higher than that of the alleged light-emitting-layer material, DPVDPAN is not prevented from capturing electrons and the driving voltage becomes high. See, e.g., Example 4 in which the claimed conduction level relationship is not satisfied. Compared to applicants' Example 1, Example 4 exhibits lower light emitting efficiency even at a higher driving voltage (see Table 3 at pages 49-50 of the specification).

Thus, Sakai does not disclose all elements of applicants' claimed invention, or disclose

Serial No.: 10/535,311

Docket No.: 28955.1050

anything that would have suggested applicants' claimed invention to one of ordinary skill in this

art. Further, there is no disclosure or teaching in Sakai, or otherwise in this record, that would

have suggested the desirability of combining any portions thereof effectively to anticipate or

suggest applicants' presently claimed invention. For all the foregoing reasons, applicants

respectfully request reconsideration and withdrawal of this rejection.

Accordingly, all claims are now fully in condition for allowance and a notice to that

effect is respectfully requested. The PTO is hereby authorized to charge/credit any fee

deficiencies or overpayments to Deposit Account No. 19-4293. If further amendments would

place this application in even better condition for issue, the Examiner is invited to call

applicant's undersigned attorney at the number listed below.

Respectfully submitted,

STEPTOE & JOHNSON LLP

Date: December 16, 2010

Houda MORAD

Roger W. Parkhurst

Reg. No. 25,177

Houda Morad

Reg. No. 56,742

STEPTOE & JOHNSON LLP 1330 Connecticut Avenue, NW Washington, DC 20036

Tel: 202-429-3000

Fax: 202-429-3902

有機EL技術と材料開発 Organic Electroluminescence Technology and Material Development

5

第1章 長寿命化技術

1 材料からのアプローチ

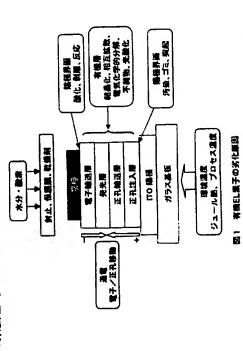
佐藤佳晴

お手を開

有機BL素子の劣化は,①輝度の低下(初期及び長期),②定電流駆動時の電圧上昇,③非発光筋(ダークスポット)の成長,④絶縁破壊(短絡)という現象として現れる。さらには,これらの劣化現象が温度とともに加速されることにある。以上の現象は,ディスプレイへの応用において,解決しなければならない課題である。図1に低分子機構型の基本素子構造と,考えられる劣化展因を示す。

これまでに、上記の劣化現象を引き起こす原因として、以下のことが考えられてきた。 非品質有機製の凝集・枯晶化"、有機層間の相互拡散""、有機材料の電気化学的分解"、有機 個と電極間のコンタクト不良""、ITOによる有機層の酸化"、陽極界面でのエネルギー障壁"。 ITO表面の汚れ・異物"、対止及び保護機の重要性"、結構の有機層への拡散消光"。

以上の劣化原因の多くは、低分子と高分子とで共通であると考えられる。



* Yoshiharu Sato 脚三菱化学科学技術研究センター 光電材料研究所 副所長

第1章 長寿命化技術

表 1 菓子の劣化原因:内的原因

温味	電橋コンタクト不良 有限材料の相互拡散	電腦との反応
有機材料	戦の形状気化(猿猴・結晶化)	酸化・還元に対する安定性 勒起状態(光化学的)安定性
分配	物理的劣化	化学的劣化

図1に示した劣化原因は、外的委因と内的委因の二種類に大きく分類される。外的契因としては、環境からの水分や酸素が上げられるが、これに対しては対止技術の進歩により実用可能なレベルまでに改善された。もう一つの環境因子として温度が挙げられるが、これに関しては、有機材料をれ自身の耐熱性(例えば、ガラス配移温度)の影響が大きいので、外的な条件ではあるが、有機材料の問題ということもできる。現在直面しておりかつ今後の長寿命化のために重要なのは、有機材料に関わる内的委因である。これらは、物理的なものと代学的なもの、ベルク現象と界面現象が絡むものとに大切される(表1参照)。

有機材料の安定性については,ドーピング効果,配権界面の観点から次節で考察する。

1.2 有機材料の改善

.2.1 ガラス配移運復

有機薄膜の形状安定性は、特に低分子系材料を用いた素子において、研究初期から大きな問題であった。これに対しては、適切な分子設計により均一で安定な非晶質験を形成し、高いガラス低待位度(TB)を有する材料が開発されてきた。この分子設計の代表例が、スターバースト型化合物である。もう一方のアプローチは高分子化である。

海線形状の安定性は、主として素子の耐熱特性に影響を与える。有機層間、例えば、正孔輸送層と発光層間で分子の相互拡散が起こると、電流一電圧特性が高電圧側にシフトすることが知られている。正孔輸送材料として研究的期に用いられたTPDはガラス低移選度(Tg)が63℃と低く、耐熱性に問題があったが、a-NPD(Tg=96℃)の登場により耐熱性が改善され、実用化へ大きく前道できた。このことからも特に正孔輸送材料については、高Tg化が重要なポイントである。

高TBを行し、かつ、安定な非仏質構造を与える正孔輸送材料に関しては、『電子の数を増やす、剛直分子を導入する等の分子設計が考えられるがw,スターバースト化w,スピロ化w,トリフェニルアミン単位のオリゴマ化が効果的な手法である。素子の耐熱性は、基本的に、材料のTBに支配されると考えられる。過切な高TB材料を適切な素子構造で用いれば、高温駆動にも十分耐えも含素子が作製可能なことが期待される"w。

1.2.2 复氮化学的安定性

電気化学的な劣化、即ち、通電により素子を構成する有機材料が化学的に変化 (分解) することは、初期の正孔輸送材料(ヒドラゾン化合物)で観測されたい。正孔輸送圏に芳香族ジアミンケが、 a-NPD)を、発光量にAla.を用いることで明らかな電気化学的劣化はあられなくなったが、多くの駆動寿命選定において、長期の輝度低下は駆動時間に逆比例することから、何らかの通電電荷に依存する劣化過程があると推測される。Ala.は電子輸送層に用いられているが、 格徴でのサイクリックポルタンメテリイにおいて、選売サイクルが不安定はことが報告されていることから。。 品体状態においてもこの不安定性が存在する可能性がある。Ala.については、ゼロックスのグループにより、正れ電流により蛍光性が失われていくという単語がされている。

1.3 有種日.材料の供いこなし技術

13.1 K-KVV

長寿命代の一つのポイントは、発光器への色素ドープである。ドープしない素子でも長寿命代の報告はあるが、実用性能(輝度及び半減時間)に達しているのはドープしたものが多い。序章で示した収動寿命アーッは、低分子系の素子については、ほとんどがドープした素子の駆動試験による結果である。

有機EL素子で最初の実用寿命や性が報告されたのはルブレンドープ素子である。その後もルプレンに関しては、長寿命化の程告が疑さ、この色素の有用性が明らかになった。加えて、ルブレンに関しては、長寿命化の程告が疑さ、この色素の有用性が明らかになった。加えて、ルブレンは、他の蛍光色素と比較して例外的な挙動を示す。それは、濃度消光が10%程度の高濃度においても脳者でない点である。クマリンやDCMという代数的なレーザー色素の最適濃度は、1%程度のものが多いのと対照的である。このことは、ルブレンの分子構造に深く関わっている。ルブレン分子においては、ナッチセン特格に4個のフェール基が置換しているが、これらのフェール基间士は立体障害により互いに回転した構造になり、分子全体としては平面構造とはなっていない。このために、分子間の相互作用が高まり、二重体形成が抑制され、濃度消光しにくくなっていると解釈できる。

もう一つルブレンに特徴的なのは、同等の正孔及び電子移動度を有する。つまり、両極性の材料である点である。また、HOMO及びLUMO単位が、ホスト材料であるAlq,のHOMO-LUMOギャップのほぼ中間に位属し、正孔及び電子トラップとして機能し、再結合中心として効果よく機能する点である(図2参照)。さらに、サイクリックボルタンメトリイにおいても、可逆な酸化及び選元サイクルを示し、電気化学的に劣化することが少ないと考えられる。また、過度消光も示さないことから、ルブレンドープ素子の発光輝度は温度放存性を示さず、高温駆動特性も良好である。比較のために示したジメチルキナクリドン(DMQA)のHOMO博位は、Alq,のHOMO

第1章 反寿命化技術

	-1.37	OMOA	+1.11	
	-1.53		+0.80	
通元官位 -1.89		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	展化調合	+1.14

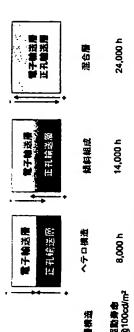
図2 別光編ホストとドーパントのエネルギー学位

単位に近接しており、再結合型の発光機構を想定すると、ルブレンと比較して有利とは貫えない。 発光機構はまた、劣化機構にも関わっている。すでに指摘したようにAlg-は酸化劣化すると考えられるので、ドーパントが酸化に対して安定でかつ、正孔を効率よくトラップすることができれば、Alg-が酸化劣化する確率が減少すると考えられる。

1.3.2 退合ホスト

ドービング機構のところでも述べた頃に、Algitホスト材料として酸化に対して弱いという欠点を行すると想定される。ドーパントは遺版が小さいために、ドーピングによるAlgiの酸化劣化抑制には限界がある。さらなる改善の方向性として、酸化に強い正孔輸送性のドーパント材料を、より極重度でドーブすることであるが、発光ドーパントの場合、一般に、濃度消光現象が高濃度では結合、蛍光量子効率が大きく低下するので、ドーパントの分子設計をのものを見直す必要があるる。

発光層中にドーパントとは別なる正孔輸送材料を混合して、Algaの電子輸送性とパランスをとりながら、Alga自体の酸化劣化を妨ぐ試みがなされている。図3に発光層を上記の製点から般けした例を示す"。コダック社の最初の報告は、正孔輸送職と発光器(電子輸送器)を2届に分けることが本質であったが、この研究報告では、通常のヘテロ接合を、傾斜組成にしたもの、完全に避合したものと比較している。劉動寿命の長さは、ヘテロ接合を傾斜組成く混合。の動になっており、発光器の組成を根本的に検討することにより、長寿命化の方向性が確認できたと言



ITO/CuPc/a-NPD/Aiqs/LiF/Ai

図3 発光層の設計的。

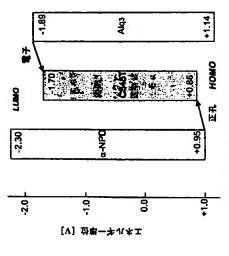


図4 混合発光層におけるエネルギー単位

, える。組合発光層の考え方は, モトローラ社からもすでに報告されており", DMGAをドーバントして, a-NPDとAlgの1:1の混合発光層を用いて, 長寿命化が達成されている。

社合発光層に用いられている各材料のエネルギー単位を図りに示す。ホスト材料であるα-NPDは正孔をそのHOMの単位を通して輸送し、Alq,は電子をそのLUMの単位を経て輸送する。ドーパントであるクァリン色素(C545T)において、正孔はα-NPDからC545Tへ、電子はAlq,からC545Tへと移り、再結合がドーパント上で起こると考えられる。この機構は、従来の、ホストーゲスト型再結合発光において、ホストは必ずしも同一材料である必要はなく、適切なHOMO-LUMの単位を有する材料であれば、2元系にすることも可能なことを示している。これは、機

第1章 長寿命化技術

能分離という考え方であり、Algaにとって、劣化をともなう正孔輸送(酸化過程)を行わなくてすむという点で、技が命化が達成されていると考えられる。

高分子材料を用いた有機匹素子では,単一の高分子材料に銅路等により異なる電荷輸送機能を有する基を導入して,正孔も電子も輸送できるパイポーラーは材料設計が検討されている。現なる機能を有する材料を混合組成物とする考え方は,極めて現実的なアプローチであるが,3元系以上となるので,真空蒸着法では3元同時蒸資といった操作を制御することが求められる。この点においては,違式プロセスの方が,多成分系数の作製には適していると言える。

最合発光層の概念は, 今後, 材料開発及びプロセス開発の対象となることが, 長寿命化の観点 からは予想される。

1.4 電極界面の製御

素子の劣化を考える上で、電筒パランスが重要なことが前面で示された。発光量をパイポーターな特性を示すように設計することが一つの条件であるが、発光器への正孔及び電子の注入条件が制御できることも重要になってくる。

・ILO電艦からの正孔注入に関しては,第5章で述べられるが,索子構造上,正孔注入蹟は最初の有機器となるので,耐熱性の観点からも非常に重製な層である。

もう一つの大きな問題点として、陰極界面が挙げられる。これは有機薄膜が電気的にオーミックコンタクトしにくいという点と、物理的な付着力が弱いという点を含んでいる。電気的なコンタクトに関しては、適切な界面部を電極界面に設けることにより、大きく改善できることが実面されている。陰痿と有機層の界面に、アルカリ金属またはアルカリ土類金属を含有する化合物を0.5nm程度の極薄版層として設けることにより、電子注入障壁が下げられることが報告されている***。LiF界面積では電子注入の促進が実験結果として得られているが、このことは、UPS調定で観測されたAlq,のHOMO/LUMOレベルのシフトで説明できる。

上記の陰低界面層が駆動安定性に与える影響については,従来のMgAg及びAlLi合金系陰低材料と比較して,十分なデータが報告されていないのが現状である。金属似子が直接有機論とコンタクトし反応することが報告されているので,陰極界面層の存在はこの界面の反応を抑制する手法として有用であるかもしれない。今後の劣化との関連に関する研究がさらに必要である。

リン組光素子の劣化機構については、発光機構とともにまだ十分に解明されたとは置い組いめ、 陽極バッファ層の導入と正孔阻止材料の改良により、駆動寿命は改善されている型。但し、同じ 電流密度で蛍光素子と比較するとまだ耐久性が十分でないと言える。ドーバントであるIr(ppy)。 構体については、電気化学的測定により酸化・遠元ともに可逆であることがわかっている。従って、現在までの総封では、反方命化には正孔阻止材料及びホスト材料の検討を必要とする。従来て、現在までの検討では、反方命化には正孔阻止材料及びホスト材料の検討を必要とする。従来

7

育概EL材料技術

の蛍光発光素子についての劣化飲材の経験が、リン発光素子の長寿命化に大いに役立つことが関

×

- 1) E.M. Han, L.M. Do, N. Yamamoto and M. Fujihira, Synth. Met., 273, 202 (1996) 2) M. Fujihira, L.M. Do, A. Koike and E.M. Han, Appl. Phys. Lett., 68, 1787 (1996) 3) Y. Sato, S. Ichinosawa and H. Kanai, IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics
- Y. Sato, S. Ichinosawa and H. Kanai, IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics. 4, 40 (1998)
- Y. Sato and H. Kanai, Mol Cryst. Liq. Cryst., 253, 143 (1994) \$
- J. McElvain, H. Antoniadia, M.R. Hueschen, J.N. Miller, D.M. Roitman, J.R. Sheats and R. L. Moon, J. Appl. Phys., 80, 6002 (1996) 3
- J. C. Scott, J. H. Kaufman, P. J. Brock, R. DiPietro, J. Salem and J. A. Goitia, J. Appl. Phys., 79, 2745 (1996) 9
- C. Adachi, K. Nagai and N. Tamoto, Appl. Phys. Lett., 66, 2679 (1995)
- 河原田, 大石, 斉藤, 夏谷川, 月刊ディスプレイ, 4, 50 (1998) 2 8
- 9) 'IIL', 内语, 大组, 中田, 第45回応用物理学因係連合調査会, 29-C-10 (1998) 10) E.I. Haskal, A. Curioni, P.P. Seidler and W. Andreoni., Appl. Phys. Lett.
- E.I. Haskal, A. Curioni, P.F. Seidler and W. Andreoni., Appl. Phys. Lett., 71, 1151
- K. Naito, Chem. Mater., 6, 2343 (1994)
- Y. Shirota, Y. Kuwabara, D. Okuda, R. Okuda, II. Ogawa, H. Inada, T. Wakimoto, II. Nakada, Y. Yonemoto, S. Kawami and K. Imai, J. Lumin., 72-74, 985 (1997) 3 5
 - H. Spreitzer, H. Vestweber, P. Stoßel and H. Becker, Proc. SPIE 2000, 4105, 125 9
- 上村、奥田, 上礼, 小野, 俤, SEIテクニカルレビュー, 158, 61 (1999)
- H. Murata, C.D. Merritt, H. Inada, Y. Shirota and Z.H. Kafafi, Appl. Phys. Lett., 75, 3252 (1999) ₹ <u>3</u>
- Marder. G.E. Jabbour, S. Shaheen, B. Kippelen, N. Peyghambarian, R.M. Wight-J.D. Anderson, E.M. McDonald, P.A. Loe, M.L. Anderson, K.L. Ritchie, H.K. Ilall, T. Hopkins, E.A. Mash, J. Wang, A. Padias, S. Thayumanavan, S. Barlow, S.R. man and N.R. Armstorng, J. Am. Chem. Soc., 120, 9646 (1998) 9
 - H. Aziz, Z.D. Popovic, N.X. Hu, A-M. Hor and G. Zu, Science, 283, 1900 (1999)
 - A.B. Chwang, R.C. Kwong and J. Brown, Proc. SPIE., 4800, 55 (2003)
- V-E. Choong, S. Shi, J. Curless, C-L. Shieh, 11.-C. Lee, F. So, J. Shen and J. Yang, Appl. Phys. Lett., 75, 172 (1999) 5 8 6
 - T. Wakimoto, Y. Fukuda, K. Nagayama, A. Yokoi, H. Nakada and M. Tsuchida. IEEE Trans. Electron Devices, 44, 1245 (1997) ଛ

第1章 長寿命化技術

- T. Watanabe, K. Nakamura, S. Kawami, Y. Fukuda, T. Tsuji, T. Wakimoto and 21) L.S. Hung, C.W. Tang and M.G. Mason., Appl. Phys. Lett., 70, 152 (1997)
 - S. Miyaguchi, Proc. SPIE 2000, 4105, 175 (2000)

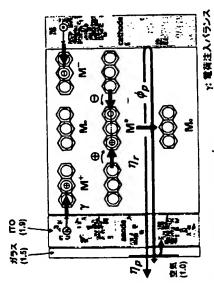
第2章 高発光効率化技術

1 リン光EL素子の原理と発光機構

河村祐一郎",合志第一",安遠千波矢"

1.1 Introduction

図1に有機BL業子の発光メカニズムを示す。陽橋からホールを路橋から電子を注入し、注入された電子とホールは有機層内を輸送され、ある分子において再結合を起こし分子酚起子が生成される(図1)。この際に、電子とホールのスピンの組み合わせには4つの固有状態が存在し(図2);一重項酚起子と三重項酚起子が1:3の割合で生成される''。そのために、蛍光をEL



 $\eta_{ext} = \eta_{int} \eta_p = \gamma \eta_r \phi_p \eta_p$

n; 励起子生成效率 4。完光量子效率 n。光吸少出し效率

図) 有後に兼子の電荷注入・輸送・再結合通程

- 1 Yuichiro Kawamura (独) 科学技術展現機構
- 2 Kenichi Goushi 千歲科学技術大学大学院 光科学研究科
- Chihaya Adachi 千歲科学技術大学 光科学图 物質光科学科 教授;(独)科学技術版學與與機

第2章 高発光効率化技術

に用いる場合は励起子生成効率が25%、リン光をELに用いる場合は75%~100%と大幅に 動起子生成効率が向上することになる。現実 に、現在では、17系リン光材料を用いること により、緑色発光で19%1、赤色発光で7 %1、青色発光¹¹に関しても10%を超える 外部量子収率(n。)が報告されているが、

Triplet Triplet Singer Singer

豊した際、内部量子仅率(nm) が緑色発光においてほぼ~100%に対途していることを示唆している'''。この様に、有機金属リン光材料を用いた有機免光ダイオード(OLED)は、現在、内部置子効率が100%に迫る究極の発光効率を実現した。本節では、イリジゥム系有機金属リン光材料の光励起・失活過程の基礎についてEL過程との相関から述える。

1.2 F来リン光材料

図3に一般的な有機分子のエネルギー状 學図を示す。通常、光砂起下においては、 S. (基底状態) からS. (一重項励起状態) への光吸収が生じ、基底状態に戻る際に放 引される光を蛍光(fluorescence) といい、 スピンが内部組場効果により反転し三重項 励起状態へ運移し、そこから放射失活して 基底状態へ遅ら過程をリン光(phosphorescence) と言う。リン光は、励起等命が長

.

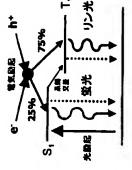


図3 電波器名通程と光路配通程による 分子部配子の生成 いため、通常、総合する強い条矢舌プロセスの存在のために、重選では設備されない弱点がある。 そのため、三重項助起子を利用することは、通常、有機匠においては高い発光が単を弱待する ことができない。三重項を用いれば高い発光が率が得られることは、原理的には1960年代から分 かっていたことであるがい、実際には、変量において高いリン光量子収率を有する化分物を相続 なるていたことであるがい、実際には、変量において高いリン光量子収率を有する化分物を相続 な簡合多理芳香誌から見つけ出すことは拍離である。例えば、リン光物質として代表的な化合物 としてBanzophanone(BP)誘導体がある。BPは蛍光を示さないことから、系間交換の過度定 数はka~10*a 「程度の高い値を有し、かa-100%を意味する。ここで77Kの過度から、BPのリン光の量子収率は0.90、三重項励起状態の励起券命は6×10**eであり、リン光の追促定数ka~150。三重項係数約失活の速度定数ka~20s**が得られる"。ここで77kの適は温度により、

有限EL材料技術

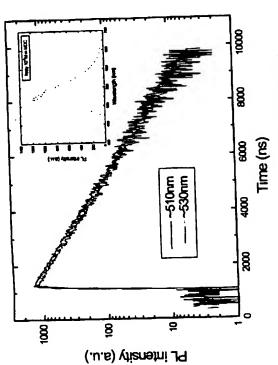


図4 ジクロロメタン中におけるIripovisのリン大都をイリン光スくひトラ

あまり変化しないが、Leit温度と共に増加し、25℃では、km~10'の値を有する。従って、筆 温では事実上リン光は観測されないことになる。さらに有機ELデバイスとして考えた場合。仮 に低温にすることでリン光の量子収率が高い場合でも、リン光寿命がma~秒オーゲーの長い値 を有すために、EL過程において、助起状態の始和や三重項ー三重項消滅(Triplet-triplet annihi-を有すために、EL過程において、助起状態の始和や三重項ー三重項消滅(Triplet-triplet annihi-高くても、助起み命が長い限りデバイスとしては使えないことになる。実際、1990年において、 高くても、助起かゆが長い限りデバイスとしては使えないことになる。実際、1990年において、 審告らは、Benzophenone (BP) 誘導体を発光材料に用いてEL発光を観測しているが、発光が 審合は、Benzophenone (BP) 誘導体を発光材料に用いてEL発光を観測しているが、発光が 確立に関いること。また、砂粒状態の飽和現象を観測している mung- 一方、Ir、Ptなど 値域の個に関与れていること。また、砂粒状態の飽和現象を観測している mung- 一方、Ir、Ptなど 値域の配状態の熱側温移が観点され、放射失活過程の適度定数が比較的大きいことに加え、 とな光を示し、発光寿命は液長に大きく依存せず~3 μsの値を有する。この発光は、MLCT にMatal to ligand charge transfer)の三重項状態からの放射過移であり、Irの重原子効果による強い傾動が放射過移を可能にしている。

第2章 高発光効率化技術

固体状態において効率の良いリン光発光を得るためには、濃度消光を防ぐために窒光材料と同様にゲストーホスト型の分散構造が必要である。[r(ppy),の場合、~i5wt%以上の濃度において始者な濃度消光が観測されるが、蛍光材料と比べて濃度消光が起きる濃度は高めである。これは、一つには、分子形状が球形に近いために、分子間相互作用が弱いものと考えられる。また、高効率を得るためにホスト材料の選択は重要であり、ゲスト分子よりも大きな三重項エネルギーを有することがエネルギー閉じ込めの観点から必須である。現在、三量項励起子の閉じ込め効果、耐久性、bipolarキャリや輸送性の製点からCBP(4,4*-dicarbazoly|-1,1*-biphenyl)***の#スト材料として多用されている。

1.3 lr(ppy),のPL機構(1): 低温におけるlr(ppy),の特異な発光特性^u

一般的に芳香族有機化合物は、低温になるに従い励起子の非放射失活過程が即約されるため、 蛍光強度の増大と共に発光寿命の増大が見られる。同様にS,からT,への系間交換(ISC)の大きな 材料では、低温下においてリン光発光が観測される。一方,図5にCBP中にIr(ppy),を分散した 系におけるPL発光強度と寿命の温度依存性を示すが、この様にPL強度は温度依存性を全く示さ ず、発光寿命はT~50以以下になると急激に及くなる特異な現象が観測される。この原因として ニつのメカニズムが考えられる。①ゲスト材料であるIr箱体とホスト材料であるCBPの三重項エ ネルギー準位間の相互作用(back energy transfor)が原因である。②Ir化合物の内部失活の特

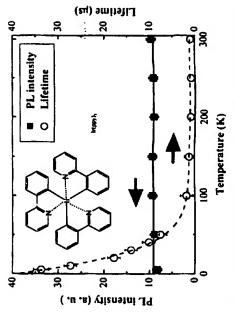


図5 CBP中にIr(ppy)を共募着した課職におけるPL発光強度と寿命の温度依存性

有做EL材料技術

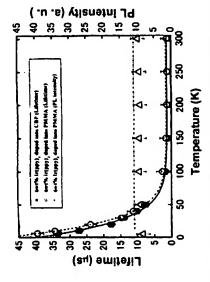


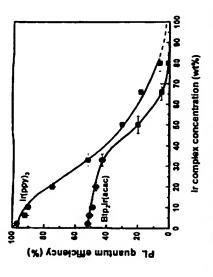
図6 PMMA中にfr(ppy)を分散した分散機におけるPL発光技質と身命の温度依存性

性であり、Ir化合物の複数の三面項励品準位からの放射運移程率もしくは項間交差速度に温度依存性があるため発光等命が変化する。などのメカニズムが考えられる。そこで、これらのメカニズムを検証するためにPMMAにIr(ppy),を6wt%ドープして、りん光寿命とPL強度の温度依存性を適定した。PMMAは光学的に不活性媒体であり、Ir(ppy),との間でエネルギー移動を生じないメリットがある。図6は、Si基板上にスピンコート法で薄膜を作取し、温度を5~300Kまで変化させストリークカメラを用いてPL過度スペクトルを測定した結果である。與体深いことに、CBPをホストにした場合と同様に、Ir(ppy),のPL強度は温度依存性を示さないのに対し、免光寿命はT-50K以下において顕著な温度依存性を示した。このことから、PL強度と発光寿命の特異な温度特性は、Ir(ppy),の内部失活の特性であると結論できる。

1.4 PL絶対象子収等の選定と議収依存性¹⁴

PL強度が過度依存性を示さないことは、n=~100%を示唆している。そこで、Ir前体のn=を求めるために、値分替を用いたIr指体ドーブ膜の絶対発光量子収率(n,)の結עを図7に示す。CBP中に緑色発光路体Ir(ppy)を2~80wt%(1.5~75mol%)ドーブした薄膜(100nm)のnn及び r_のドーブ連度依存性を確定したところ、2 wt%及び 8 wt%的でそれぞれ n n=97±2%、92±3%が得られ、実際に n=が~100%に近い値であることが確認された。更に 6 wt%時に赤色光路体Biplir(acac)では n n=51±1%が得られ、OLEDの n=から予想される発光効率と良好な一致を示した。つまり、Biplir(acac)は何れの温度域においても三重項レベルからの温度に依存しない無失活過程を行することがわかった。よって、赤色リン光は材料の最適化により、U

第2章 馬克光効率化技術



7 CBP中におけるir(ppyhとBtp.ir(ecec)のPL他対象子仅率の過度依存性

にEL効率を2倍向上できる可能性がある。

いずれの結体もドープ重度の増大と共に顕著な n_R の域少 $n_R = \frac{k_B}{k_B + k_B + k_B} + k_B$ が設置されたが、この効率減少に対し $\Gamma(ppy)_3$ の $n_R(tk_B)$ 、事度消光速度定数 (k_B) を用いて(1) 式のように表すことができる。各重度における $n_R + k_B + k_B$

Ξ

8

小さいと仮定)。得られたkooに対し、結体のmol%から求めた平均分子間距離とForsterやエキルギー移動の式(2)を用いてfittingを行ったところ,実験値との良好な一致が見られ、CBP酸中のIr(ppy)の濃度消光塩界距離はK--1.32nmと見積られる。

1.5 lr(ppy),の三重項数起状態の閉じ込めと散逸過程¹⁰

ゥん光物質を免光材料に用いる場合、高効率泡光を得るためにはホスト分子による三市塩砂位 の閉じ込めに注意しなければならない。しかしなから高効率洗光をOLEDディイスで得るために は、ホスト材料に対してのみではなく両結合サイトとなっている界面近傍、すなわち発光温と路 様するホールもしくは電子輸送器の三型項準値に対しても十分な注意を払う必要がある。一般に ITO/a-NPD/Ir(ppy),: CBP/BCP/Alq,/MgAgなどのa-NPDをホール輸送器に用いたディ イス構成においては発光効率が~12%程度に留まっているのに対し、ホール輸送器に円いたディ bis(N-(p-tolyl)-N-phenyl-amino)biphenyl]茶のジアミン誘導体を用いると値かながら発光効率が含むが必要が向上する場合が多い。これはTPDの三単項レベルに比へa-NPD(47-bis(N-(1-naphthyl))-

Charles Carrier Callet Marte

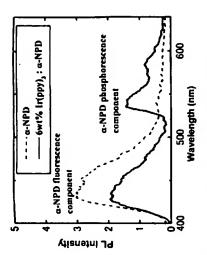


図8 T=5Kにおけるa-NPDと6wt%-htppy):a-NPD裏のPLスペクトル

N-phenyl-amino)biphenyl]の三重項準位の方が10nm程長波長側に存在し励起子の閉じ込めが不十分であるため、ホール輸送層の三重項準位へ励起エネルギーが移動し、そこで非放射失活し発光効率に至ったと考えられる。このことを実験的に確かめるためSI落板上にIr(ppy))を6wt% ドープしたα-NPD海闕(50nm)を作製し、温度を5~300Kまで変化させストリークカメラを用いてPL過度スペクトルを創定した。また比較のためにホスト材としてTPD, CBP, TRZ (トリアン)移導体) についても検討した。

図8にa-NPD膜及びIr(ppy)。をwt%ドープしたa-NPD膜におけるT=5 K時のPLスペクトルを示す。540nm近傍の治光はIr(ppy)。ではなくa-NPDのりん光成分である。実験はIr(ppy)。をドープしたa-NPD順における発光スペクトルを示すがIr(ppy)。は全代を示さなかった。現場はIr(ppy)。ないてa-NPDのりん光成分である。実験はIr(ppy)。ないに本ストであるa-NPDからの発光成分は来ドーブ酸に比へ、けい光強度が基少し、単細膜と比べて bPLがゆが短くなった(~1.5na)。これは390~430nmにa-NPDの治光とIr(ppy)。の吸収に係なりがあることからIr(ppy)。へれはa-NPDの一般頂準位からIr(ppy)。の一般頂準位へエネルギーが特別したは、Ir(ppy)。の一般頂準位から三般項準位からIr(ppy)。の一般頂準位へエネルギー特別した後、Ir(ppy)。の一般頂準位から三般項準位からIr(ppy)。の一般頂準位へエネルギー特別した後、Ir(ppy)。の一般頂準位から三般項等位へを原子が果により100%項間交差し生成された三角頂局は子が、再びa-NPDの三面近準位へはほ100%の効率でエネルギー移動していると考える。そのため、a-NPD単層に比べIr(ppy)。キャプしたa-NPDのりん光が強くなり、またIr(ppy)。か発光とないと結論できる。

The state of the state of the state of

第2章 高免光効率化技術

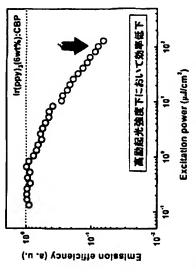


図9 Irlory/Gwrk/CBP製菓の計画の下でのPL数券の最近投資が存在をある。 国業ガメレーザー(337mm))

1.6 高弦度勘起光下におけるIr(ppy);:CBP共募倉職の光動性!!

リン光OLEDは、三重項励起子からの発光を利用することによりほぼ100%の内部量子収率が 得られるが、高電流密度下においては顕著な光光効率の低下が超過されている。その設因として、 三重項励起子間でのT-T annihilation(TTA)による失活を提案してきた。ここでは、Ir(ppy)、 をドープした有機高機圏の光励起下におけるPL効率を測定し電流励起下でのEL効率の比较から 三重項励起子失活のメカニズムについて議論する。ホスト材料としてCBPを用い、Ir(ppy)、を 6 wt% ドープした個をガラス基板上に真空無着により100mm成職し、N,ガスレーザー(数展337nm) による光励起時の発光スペクトル及び発光強度の励起光速度依存性の結果を図りに示す。その結 果、励起速度(PL)の上昇に伴いIr(ppy),のカルが減少すること、また、CBPホストの発光が出現 することがわかった。また、同れの光強度下においてもAmplified Spontaneous Emission (ASE)に落づく発光は観点されなかった。

図101cはIr(ppy);CBP構造のPL通道現象の助居強度依存性を示す。助居強度の地大に伴い、 純食曲線はsingle exponentialから大きく外れることがわかった。この依存性は、従来の下で nnnihilationのモデルでは設明ができずPorster型のエネルギー移動で説明が可能である。この ことは、三重項同士の助起子失活が、Porster型のエネルギー移動を介して生じていることを意味している。

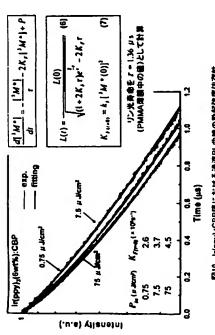


図10 h(ppy)にCBP膜における過速PL曲線の動起強度依存性

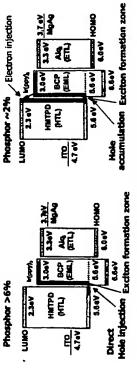


図11 有機リン光EL菓子におけるキャリヤーは入職権

1.7 Direct exciton形段監察

粉起子生成が生じる場合の二つに大別することができる。Ir(ppy),の濃度を変化させた場合,E L兇光スペクトルは,ゲスト分子の濃度に依存して大きく変化する。過格,①の機構が動いてい 有機匠における励起子生成過程には,大きく分けて2種類に分類できる。①ホストで励起子 る場合、濃度の減少と共に、ホスト材料の発光が見られるが、リン光デバイスの場合、ホール輪 送付籍(HTL)の発光が強くなっていく様子が見られ、このことは、ゲスト分子の濃度が高い 場合は、HTLからゲスト分子のHOMOレベルにホール注入がダイレクトに生じ、土にホストに が生成されゲスト分子にエネルギー移動する過程と回ゲスト分子でダイレクトにキャリヤ再結合・

第2章 高雅光効率化技術

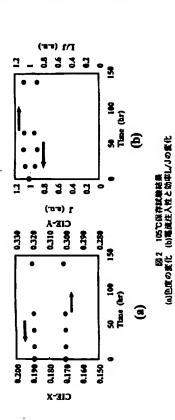
ト分子のHOMOレベルに注入できず,逆に属子注入がHTL内邸に生じてしまい,HTL内でも励 HTL/発光解界面においてゲスト分子へのホール注入サイトが減少するために、ホールがゲス 呂子生成が生じてしまうことを意味している。CBPをホストとしたデバイス構造においても尚 単な発光スペクトルのゲスト分子濃度依存性が見られ,Directな電荷再結合過程と励起子生成が よって運ばれてきた電子と再結合すると考えられる(図11)。一方,ゲスト濃度が低い場合では。 リン光デバイスの特徴的な過程である。現在,高効率発光が得られているリン光デバイスでは, キャリヤートラップ機構による励起子生成を経由している場合が多い。

- M. Pope and C. Swenberg. Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers* (Oxford Science Publications) $\widehat{}$
 - C. Adachi, M. A. Baldo, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett., 77, 904 (2000) 2
- C. Adachi, M. A. Baldo, S. R. Forrest, S. Lamansky, M. E. Thompson and R. C. Kwong, Appl. Phys. Lett., 78, 1622 (2001) 3)
- C. Adachi, Raymond C. Kwong. Peter Djurovich, Vadim Adamovich, Marc A. Baldo, Mark E. Thompson and Stephen R. Forrest, Appl. Phys. Lett., 79, 2082 (2001) \$

. 19 - 19 30 - 1

- S. Tokito, T. lijima, Y. Suzuri, H. Kita, T. Tsuzuki, and F. Sato, Appl. Phys. Lett., 2
 - R. J. Holmes, S. R. Forrest, Y.-J. Tung, R. C. Kwong, J. J. Brown, S. Garon, and M. E. Thompson, Appl. Phys. Lett., 82, 2422 (2003) 9
 - C. Adachi, M. A. Baldo, M. E. Thompson, and S. R. Forrest, J. Appl. Phys., 90, 5048 (2001) 2
- C. Adachi. M. E. Thompson, and S. R. Forrest, IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics, 8, 1077 (2002) ê
 - N. J. Turro. "Modern Molecular Photochemistry" University Science Books 6 9
- M. Morikawa, C. Adachi, T. Tsutsui, and S. Saito, 51st Fall Meeting, Jpn. Soc. Appl. Phys., Paper 28a-PB-8 (1990)
 - S. Hoshino and H. Suzuki, Appl. Phys. Lett., 69, 224 (1996) =
- C. Adachi, R. C. Kwong, and S. R. Forrest, Organic Electronics, 2, 37 (2001)
 - Y. Kawamura, II. Sasabe and C. Adachi, Appl. Phys. Lett., (submitted) K. Goushi, H. Sasabe and C. Adachi, Phys. Rev. Lett., (submitted)
- Goushi, H. Sasabe and C. Adachi, J. Appl. Phys., (submitted)
- Kawamura, H. Sasabe and C. Adachi, Appl. Phys. Lett., (submitted)

有機尼上材料技術



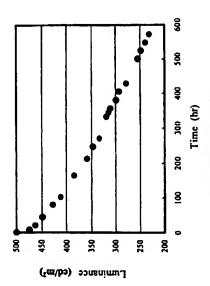


図3 85℃国動物の類度劣化

100時間以上保持しても、色変化、効率変化のないことが確認できた。また、85℃駆動では、初期障度500cd/miで半減寿命500時間以上を実現した。図3に85℃駆動試験の結果を示す。

1,3,2 青色ホスト材料の改良

青ホスト材料の改良による性能向上に関して、ドーパントにBD-102を使用した場合の結果を扱るにまとめた。

責色ホスト材料をBH-120から次世代材料「BH-140」に変更すると、初期性能は、噂度の電流効率が12.4cd/A、電力変換効率5.8lm/W、外部量子収率6.3%、色度は(0.165, 0.300) であった。このように、ホスト材料のBH-120からBH-140への変更により、効率が約20%向上した。一方、BH-140を用いた場合の寿命は、別期研度1000cd/m*で8600時間となっており、BH-120と

第6章 完光灯料

表 2 エリアカラー用骨色発光材料の性能 (ドーパントは, BD102を使用)

ı

, ¹¹¹ /P20001 = 7@	4,500hr	8,600hr	21,000hr
車(な	A/b=01	12cd/A	12od/A
अन	(0.17, 0.33)	(0.17, 0.30)	(0.17, 0.30)
424	BH-120	BH-140	NBH

表3 フルカラー用膏色発光材料の性能 (ドーパントは,BD62を使用)

, ^{W/P2} 000(=*7例 安全第二	1,100hr	1.900hr	7.000hr
#400	5.4cd/A	5.9cd/A	5.9cd/A
110	(0.16, 0.17)	(0.15, 0.15)	(0.15, 0.15)
4.2.4	BH-120	BH-140	NBH

比較するとほぼ2倍の長寿命化が連成できた。

さらに、青色ホスト材料BH-140の分子構造を徹底的に見直すことにより、さらに長寿命な新しい青色ホスト材料(以下、NBHと省略)の開発に成功した。Bii-140から新しい青色ホスト材料料NBHに変叉することにより、初期印度1000cd/m*半減寿命2万1000時間となり2倍以上の長寿命化を達成することができた。

1.3.3 フルカラー用純青材料

フルカラーディスプレイを実現するためには,ドーパントBD-102の色度では不十分であり,より短波長のドーパントが必要となる。ドーパントの構造を改良した結果。純青ドーパントとして「BD-062」を見出した。BD-062を用いた場合の青色ELの性能を表引にまとめた。

このドーパントはホストがBH-120の時代に関発されたものである。BH-120を用いた場合、(0.156, 0.165) という色度で,輝度の電流効率が5,39억/A,初期輝度1000억/m/で半流寿命は1100時間であった。

ホスト材料をBH-120からBH-140に変更することにより,高効率化,長寿命化を達成できる。 具体的には,色度が(0.15, 0.15) で,輝度の電流効率は5,86억/A,初期輝度1000억/m²での半 議寿命1900時間となり,2倍弱の長寿命化を実現している。

さらに、新青色ホスト材料NBHの場合には、1900時間だった半鍼寿命がさらに1000時間となり、BH-140の寿命に対して3倍以上の及寿命化を違成できた。

このファカナー用着色材料の長寿命行の実現により、材料性能では中小粒テレアが実現であるフィチに到達したとおえている。

1.4 青色以外の発光材料の開発

次に、青色以外の各色の発光材料の開発状況について紹介する。

この関発の考え方のポイントは、非常に長寿命で高効率な青色ホスト材料と新しいドーパント材料を組み合わせて、青色以外の色で高効率、長寿命の有機EL業子を実現するというコンセプトである。ドーパント材料としては、上述の純青以外に、緑色、黄色、赤色ドーパントを開発し

1.4.1

2003年に最色材料に関して極めて大きな進展があったので紹介する。

青色材料の寿命が大幅に改良されてきたことに伴い、従来使用されてきたAlqをホストとした 緑色材料のぶ命がつルカラー用としてみた場合には不足するという問題が顕在化してきた。また、 Alqはホールが入ると劣化すると言われており、Alqをホストとして用いる限りこれ以上の長寿 命化は扮麗であると考えられる。

そこで、我々の開発した長寿命費色ホスト材料を使用した緑色ELを実現するという考え方の下で、緑色ドーバントの開発に取り組んだ。このような考え方で開発を進めた結果、我々はフルカラー用の新しい緑色ドーパント材料の開発に成功し、青色ホストとの組合わせで、従来品緑色を大きく上向る高効率、長寿命を達成することができた。青色ホストとしてBII-140を使用した場合には、蝟貨の電流効率は195d/A、半減券のは、初期噂度1000cd/m'で2万6000時間、色度が (0.32, 0.62) であった。Alq:ファッドによる緑色と性能を比較すると、当社評価比で、効率は11.6倍以上、寿命に関しては5倍以上という大橋な改良を連成することができた。

1.4.2 珠色

赤色材料は、ホスト材料から赤ドーパントへはエネルギー体動効率が小さい、すなわち発光効率が低いという大きな問題がある。また、ドーパントを迅速度に添加すると消光し、かえって発光効率が低くなる。また、ドーパントが電荷の移動トラップとなり、製動電圧が高くなるという問題もあった。

The second secon

そこで。蛍光の量子効率の高い縮合方春度系の化合物を活用し、立体的にかさ高い震療基を利用して濃度消光を抑制するという考えで開発を進めた結果。延濃度添加が可能な新しい赤色ドーパント「RD-001」を見いだした。なお、この赤色ドーパント「RD-001」は砂石油産業活性化センターの技術開発事業の中で開発されたものである。

このドーパントは、高濃度ドープ時にドーパント間の電荷輸送が可能となり、従来の赤色材料 Alq: DCMと比べると、大幅な低電圧化を実現できた。実際、輝度100cd/m*の時の駆動電圧は Alq:DCMの場合? - 8 Vであるのに対して、Alq:RD-001では 4 Vであった。なお、この時の色度は (0.64, 0.36) であり、ホスト材料Alqに対してRD-001の濃度は21wt%と濃度の高い条件下

第6章 免光材料

で実現できた.. また, 輝度100cd/miの場合の効率は, 電流効率が3.0cd/A, 発光効率が2.11m/Wとなる。半緒が合は, 初期輝度が500cd/miで1万時間以上を達成している。

4.3 to the

ドーパントRD-001を用いて,ホスト材料をAlqから青色ホスト材料に変更することにより, 橙色の発光を得ることができる。すなわち,この赤色ドーパントは青色ホストからもエネルギー移動が可能になっている。 ホスト材料がBH-120の場合, 色度は (0.56, 0.43), 輝度の電流効率が11cd/A, 発光効率5.2 lm/W, 初期頻度1000cd/m¹の時の半減再合は 1万9000時間であった。ホストをBH-140に変えることにより、電波効率は13cd/Aとなり、効率が向上した。 没命も 3万4000時間となり、大幅な資産を建立した。

1.4.4 混合ホスト

次に,赤色性能をさらに向上させるために,混合ホストを検討したので紹介する"。

RD-001に関して1.4.2、1.4.3項で述べたように、ホストがAlqの場合、高効率な赤色EL素子が、一方青色ホスト材料の場合には、非常に長寿命な橙色EL素子が実現できている。そこで、Alqと青色ホスト材料を促ぜた混合ホスト系を作り、これに赤色ドーバントをドーピングすると、高効率かつ長寿命な赤色EL素子が実現できるのではないかと考えた。ここでは、社台比がAlq:BH-140-2.7:1の場合の結果を表々にまとめる。

まず,色度に関しては,ホストがAlq単独の場合の色度 (0.64,0.36)とほとんど同じ (0.63,0.37)の赤色素子が実現できている。一方,効率は青ホストの混合により向上した。実際,ドービング適度が約20wt%の性能を比較すると,ホスト材料がAlq単独の場合は3.5cd/Aだった電波効率が、青色ホスト材料を混ぜた場合には5.2cd/Aまで上がっている。さらに、この青色ホストを混合することで大幅に及寿命化する効果があることもわかった。凶4に一段を示すが,初期国度1000cd/miでドーピング重度が7wt%の場合,1万時間を経過しても初期の70%の確度を確保

以上の結果より、Algに青色ホスト材料を送ぜることで、色度を大きく変えることなく、高物単化、長寿命化できることがわかった。

1.4.5 🗮 色

青色ホストと黄色ドーパントYD-103の組合せで、稀めて長が命な黄色にを得ることができる。 青色ホストが、BH-120。BH-140の場合に、初期可収1000cd/m"での半減券会はそれぞれ1万 6000時間、3万2000時間以上であった。

(CMCテクニカルライブラリー) 発行にあたって

は、その時代の最先端情報を企業や研究機関などの法人に提供することを目的としたもの 幹社は、1961年創立以来、多くの技術レポートを発行してまいりました。これらの多く で、価格も一般の理工書に比べて達かに延振なものでした。

一方、ある時代に最先端であった技術も、実用化され、応用税限されるにあたって審及 期、成熟期を迎えていきます。ところが、最先端の時代に一流の研究者によって書かれた レポートの内容は、時代を経ても当該技術を学ぶ技術書、理工書としていささかも遜色の ないことを、多くの方々が指摘されています。

弊社では過去に発行した技術レポートを個人向けの廉価な曽及版 (CMCテクニカルライブ ラリー)として発行することとしました。このシリーズが、21世紀の科学技術の発展にいき さかでも貢献できれば幸いです。

2000年12月

株式会社 シーエムシー出版

有機EL技術と材料開発

(B0922)

終し風光行 **当日政策**行 2004年5月31日 初 版 2010年5月21日 曾及版

in X 佐藤 佳明 開幕 発行者

Printed in Japan

#

株式会社 シーエムシー出版 発行所 東京都千代田区内神田1-13-1 豊島風ビル **EL**S 03 (3293) 2061

http://www.cmcbooks.co.jp

(印刷 食物印刷株式会社)

O Y. Sato, 2010

落丁・乱丁本はお取替えいたします。 定価はカバーに表示してあります。

ISBN978-4-7813-0211-9 C3054 #4200E

本書の内容の一部あるいは全郎を無断で指写(コピー)することは、法律 で認められた場合を除き、音作者および出版社の権利の侵害になります。

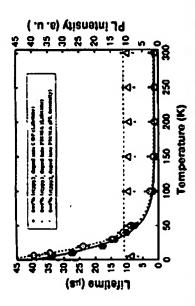


図6 PMMA中にMOMA中央数した分数数におけるPLR光型点とあるの過点位存在

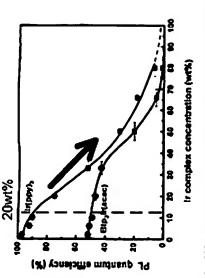
在であり、I-ILを他の複数の三角類別は単位からの数料温存留等もしくは項間交換温度に設度数存在から、LICを他の表示を存在する。 などのメカーズムがおくられる。 そこて、これらのメカーメムを検証するためにPMMAとIr(ppy)を 6 wt% ア・プレス、カム市のと下に対象の過度保存を全額でした。 PMMAは光学的に不存在はイスター・比で温度を加てメルイー体的を生じない メリットがある。因 B は、SI発表上にスピンコート社で温度を作取し、直度を 5 ~ 300K まで成化させ ストリークカメラを用いてPIに過渡スペットルを対定した結果である。 税保護いことに、CBPモラストにした場合と回復に、Ir(ppy)。PPL資度は直接保存を示して、このことから、PL位度を発送のの特別な自体を表した。このことから、PL位度を発送のの特別な自体を表した。このことから、PL位度を発送のの特別を発送を表した。

1.4 PLESS集子仅是の別院と組織技術を

PLの成の温度依存性を示さないことは、pa~100%を示唆している。そこで、Irfsはの14条のちゃた、他分ほを用いたIrfsはアーブ腺の地名Rた電子化学(pa)の結果を招き上示す。CBP中に最色発光的体Irchipy)、そ2~80mix (1.5~75molx) アーブした過程(100mm)の pm 及び raの アーブ組度依存性を倒近したところ、2 mix 及び 6 mix 的でそれでn~97± 2 Mix の アーブ組度依存を研じしたところ、2 mix 及び 6 mix 的でそれでn~97± 2 Mix の アーブ組度依存を研じてところ、2 mix 及び 6 mix 的でそれでn~97± 2 Mix の Publicace)では 2 mix の Irfs でnの 2 mix の Irfs でno I Mix out 5 i 1 Movitoられ、OLEDの paから子供される名类的学と自 所に一致を示した。つまり、Bitalicacaには何の adgitus いても三角角 レベルからの温度に 依存してい Mix を指導器を行することがわかった。よって、非色リンだは材料の最適化により、現

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

第2章 高色光色学化铁板



四7 CBP中におけるinpoylic Bushtecaciのれた対象子の中の名間は存在

に足し効果を2倍向上できる可能性がある。

いずれの部体もアープ側側の指大と共に観響なりへの成分 の m Kathatte

Ξ

4枚制造性位数 (4.)、曲度消光温度过数 (4.5) を用いて!!) 氏のように表すことができる。名種質における 0 m と km (+7.5 km ×10**) の飲より 4v4 年 掛 し た (ここで 4 th m に 比 ベ + 分

8

小さいと仮位)。得られたkoに対し、船体のmai%から求めた平均分子四局部とForsierやエネ

In order to obtain the $\eta_{a,b}$ of an Ir complex, the results of the absolute emission quantum yield (η_{rL}) of an Ir complex-doped film by using an integrating sphere are shown in FIG. 7. Dependency on the doping concentration of η_{rL} and η_{rL} of a thin film (100 nm), which was obtained by doping 2 to 80 wt% (1.5 to 75 mol%) of a green emitting complex Ir(ppy), in CBP, was measured. As result, at doping concentrations of 2 wt% and 6 wt%, η_{rL} of 97 \pm 2% and 92 \pm 3% were respectively obtained. It was confirmed that η_{abl} was actually close to 100%.

es A

3